

第83回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム

# ワイドバンドギャップ 半導体MOS界面科学の最前線

2022年9月21日（水） 午後1時30分～午後6時10分（予定）

東北大学川内キャンパス M206 + オンライン（ハイブリッド開催）

シリコンデバイス開発の歴史と同様に、ワイドバンドギャップ半導体パワーデバイスにおいてもMOS構造を構成する高品質なゲート絶縁膜の実現や、MOS界面の物性制御が極めて重要な研究開発課題となっている。本シンポジウムは、炭化ケイ素、窒化ガリウム、酸化ガリウム、さらにはダイヤモンド半導体MOS構造の界面物性やデバイス応用について材料横断的な観点から理解を深め、省エネ社会構築に資するパワーデバイス開発に関わる産官学からの研究者や学生が一堂に会して議論する場を設ける。

## 招待講演者

大森 達夫（三菱電機）

「ワイドバンドギャップ半導体関連プロジェクトの紹介および基礎科学への期待（仮）」

木本 恒暢（京都大）

「SiC MOSデバイス関連技術（仮）」

橋詰 保（北海道大）

「GaN MOSデバイス関連技術（仮）」

喜多 浩之（東京大）

「Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> MOSデバイス関連技術（仮）」

徳田 規夫（金沢大）

「ダイヤモンドMOSデバイス関連技術（仮）」

宮崎 誠一（名古屋大）

「パワー半導体のための絶縁膜界面評価（仮）」

白石 賢二（名古屋大）

「計算科学によるMOS界面の理解（仮）」

主催：薄膜・表面物理分科会、先進パワー半導体分科会

世話人：渡部 平司（大阪大学）、久本 大（日立）、小川 修一（東北大学）